

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 9 月 29 日(29.09.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/118505 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/00 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
C08G 18/30 (2006.01) C08G 101/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/056455
- (22) 国際出願日: 2011 年 3 月 17 日(17.03.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-072948 2010 年 3 月 26 日(26.03.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東洋ゴム工業株式会社 (TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 堂浦 真人 (DOURA, Masato) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 石坂 信吉 (ISHIZAKA, Nobuyoshi) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP).

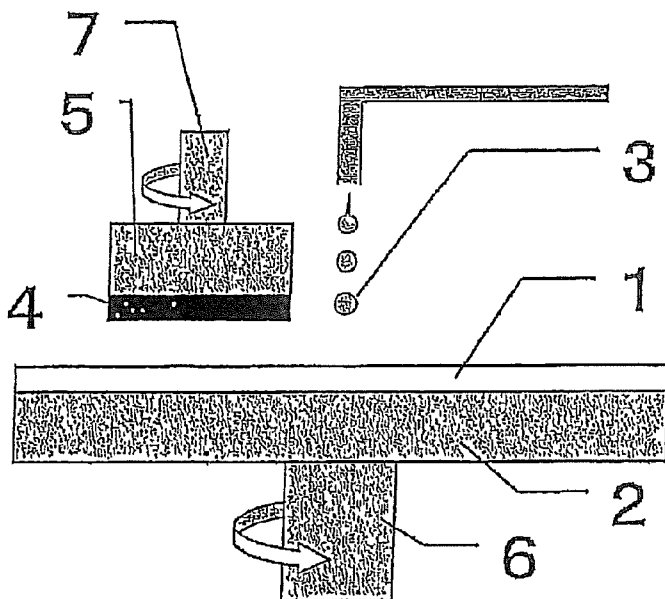
- (74) 代理人: 特許業務法人 ユニウス国際特許事務所 (UNIUS PATENT ATTORNEYS OFFICE); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 1 3-9 新大阪MTビル 1 号館 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: POLISHING PAD, MANUFACTURING METHOD THEREFOR, AND METHOD FOR MANUFACTURING A SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 研磨パッドおよびその製造方法、ならびに半導体デバイスの製造方法

[図1]



(57) Abstract: Disclosed is a polishing pad that can reduce tiny undulations on the surface of an object to be polished. Also disclosed are a method for manufacturing said polishing pad and a method for manufacturing a semiconductor device. The disclosed polishing pad has a polishing layer comprising a thermoset polyurethane foam that contains, as basic ingredients, an isocyanate component and active-hydrogen-containing compounds. Said active-hydrogen-containing compounds include a polyol compound with at least two functional groups and a mono-ol compound with one functional group.

(57) 要約: 研磨対象物の表面に発生する微小うねりを低減することができ、る研磨パッドおよびその製造方法、ならびに半導体デバイスの製造方法を提供することを目的とする。かかる目的を達成するために、熱硬化性ポリウレタン発泡体からなる研磨層を有する研磨パッドにおいて、イソシアネート成分と活性水素含有化合物とを原料成分として含有する熱硬化性ポリウレタン発泡体を使用し、活性水素含有化合物として、官

能基数が 2 以上であるポリオール化合物と、官能基数が 1 であるモノオール化合物と、を含有するものを使用する。



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))